

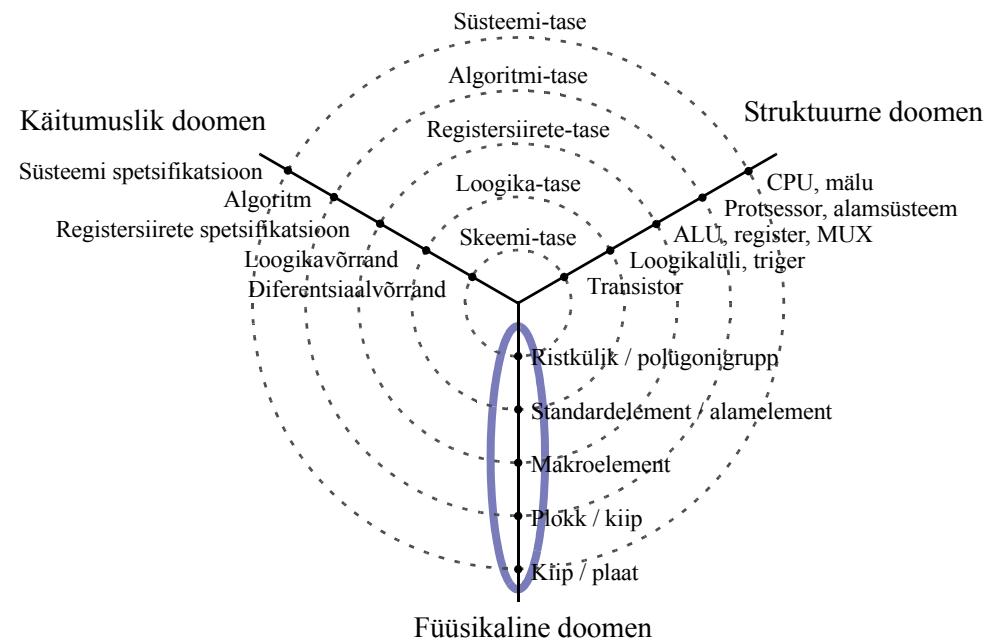


TTÜ1918



# Disaini põhetapid

- **Süsteemi disain - System design**  
a.k.a. Arhitektuuri süntees - Architectural-level synthesis
  - kirjeldus / spetsifikatsioon → plokk-skeem
  - makroskoopilise struktuuri määramine ehk kuidas on peamised ühendusplokid omavahel ühendatud
- **Loogikadisain - Logic Design**
  - plokk-skeem → loogikalülid
  - mikroskoopilise struktuuri määramine ehk kuidas on loogikalülid omavahel ühendatud
- **Füüsiline disain - Physical design**  
a.k.a. Geomeetria süntees - Geometrical-level synthesis
  - loogikalülid → transistorid, ühendusuhtmed, mikroskeem

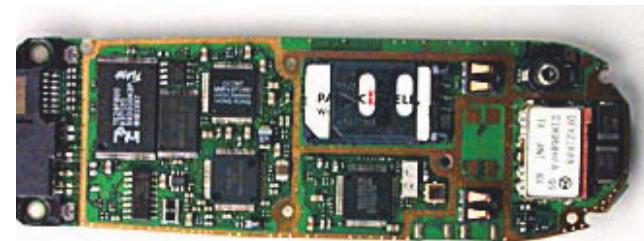
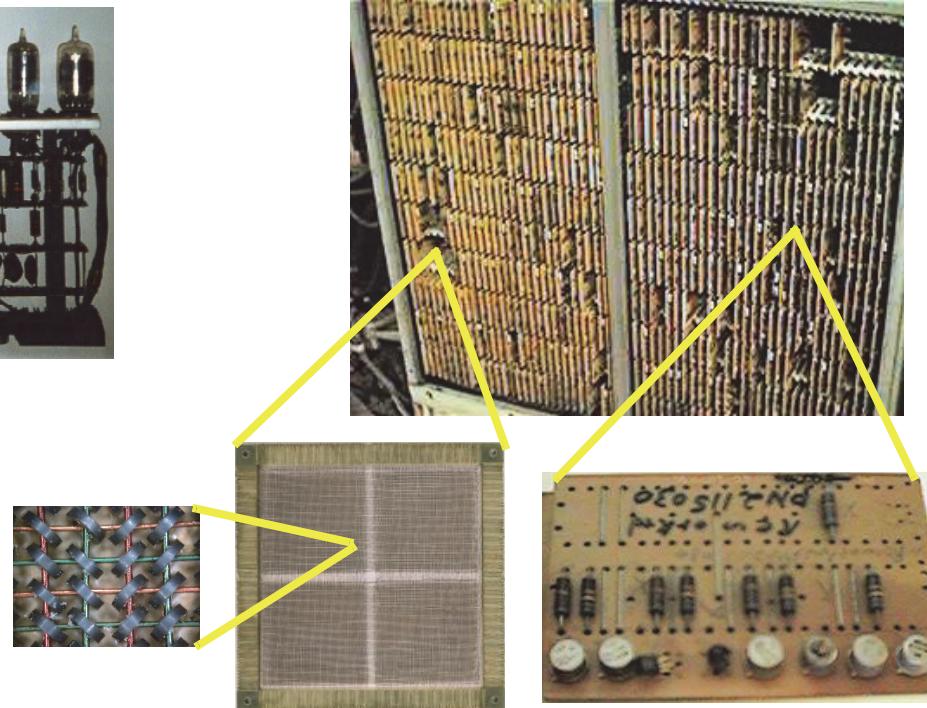
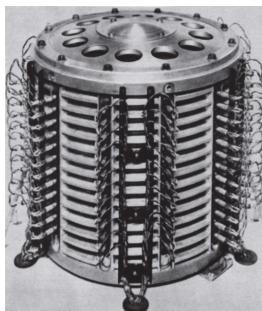
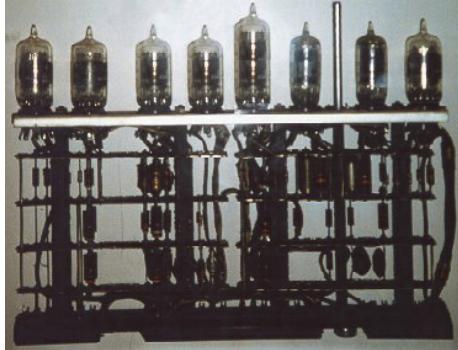




TTÜ1918



# Füüsiline realiseerimine – ajalugu ja tänapäev



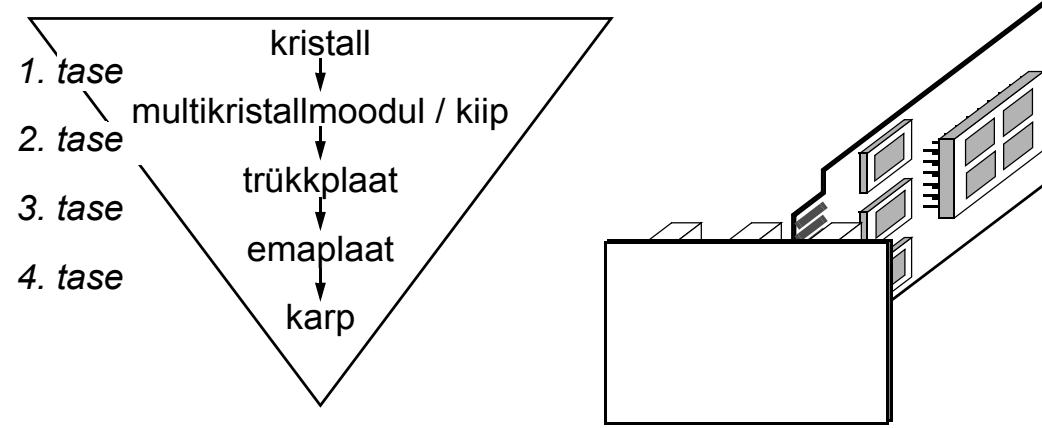


TTÜ1918



# Pakendamine

- **Pakendamise hierarhia**
  - **Lahendatavad ülesanded**
    - elektrilised
    - mehhaaanilised
    - termilised
  - **Kiipide/korpuste tüübid**
    - **Aukmonteeritavad (läbi trükkplaadi)**
      - DIP: Dual In-line Package; PGA: Pin Grid Array
      - C-DIP, CERDIP, CPGA, TBD, HDIP, PDIP, PPGA, Shrink DIP, SIP
    - **Pindmonteeritavad**
      - PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier; SOIC: Small Outline IC; BGA: Ball Grid Array
      - BQFP, CBGA, CFP, CPGA, CQFP, TBD, DLCC, FBGA, fpBGA, JLCC, LCC, LCCC, LFBGA, LGA, MLCC, PBGA, PQFD, PQFP, PSOP, QFP, QSOP, SOJ, SSOP, TQFP, TSOP, TSSOP, TVSOP, VQFB
    - [http://www.interfacebus.com/Design\\_Pack\\_types.html](http://www.interfacebus.com/Design_Pack_types.html)



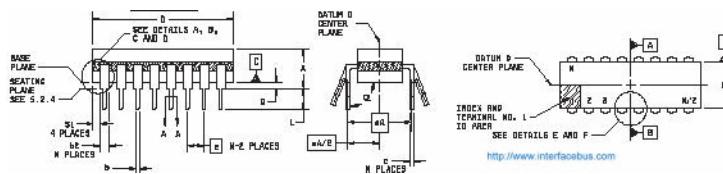


TTÜ 1918

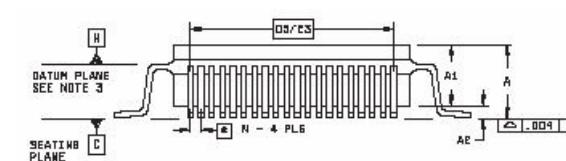


# Kiipide/korpuste näited

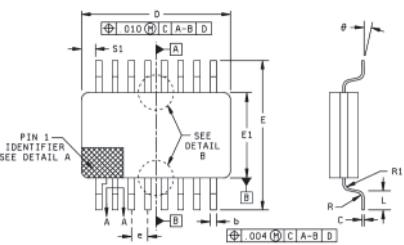
DIP



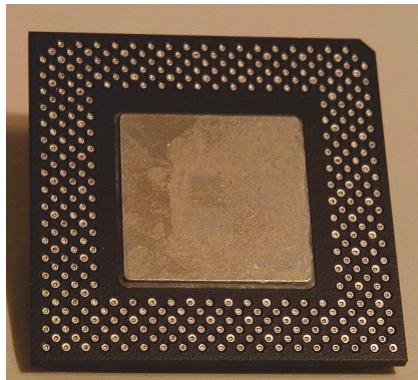
PLCC



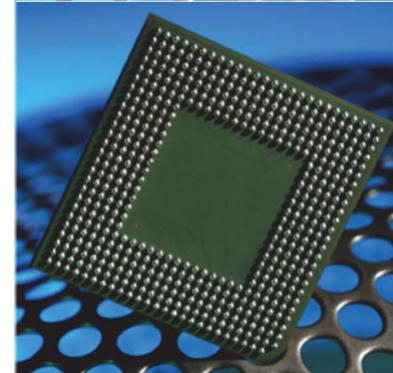
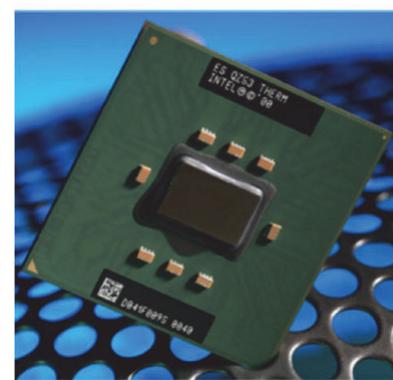
SOIC



PPGA (Intel)



FCBGA (Intel)



SEPP (Intel)



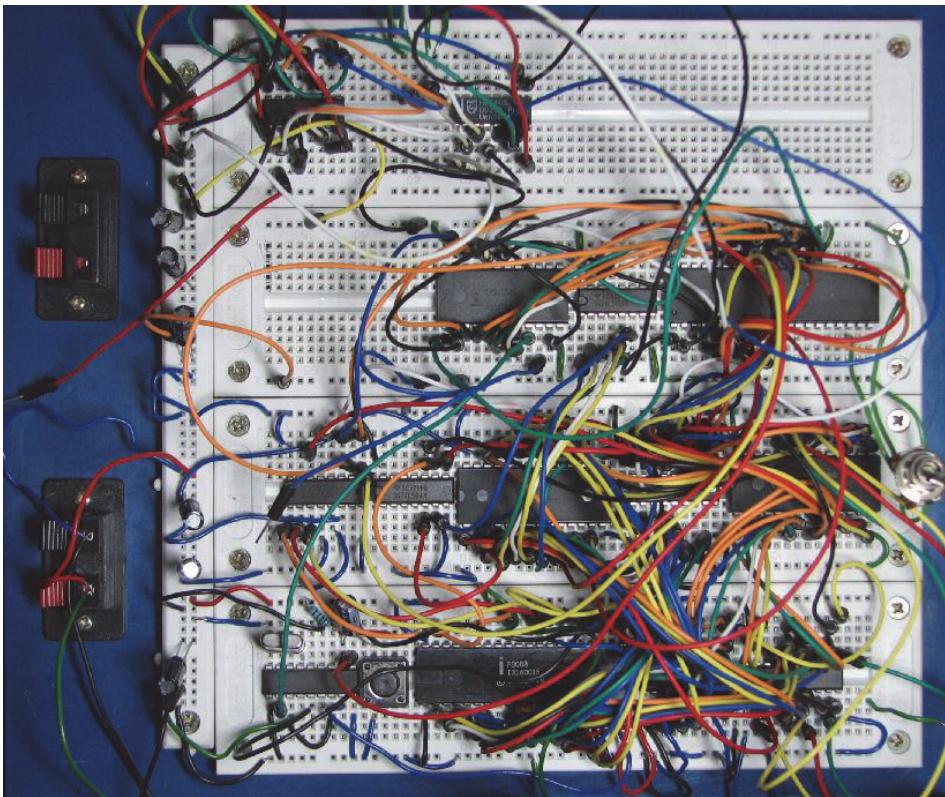


TTÜ1918



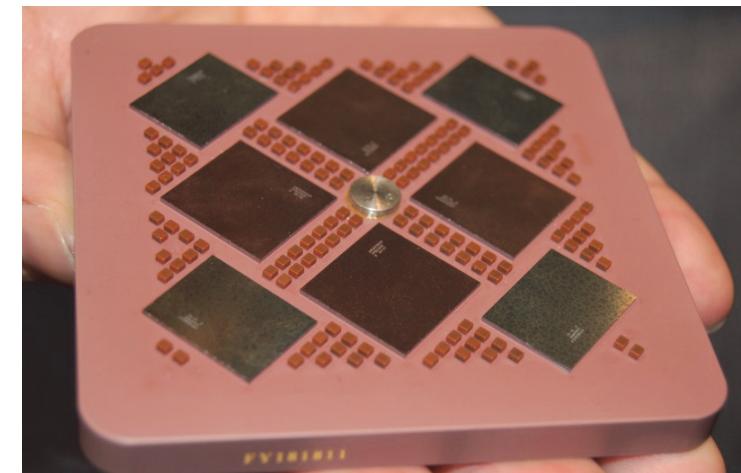
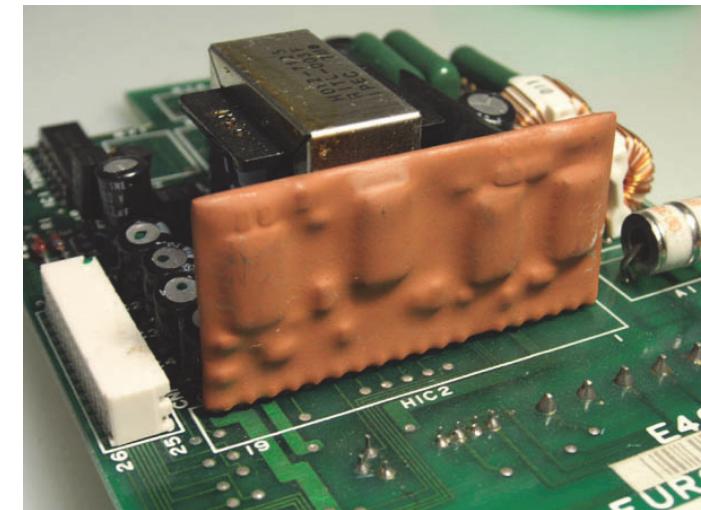
# Pakendamise näited

prototüüpimine



ruumiline montaaž

hübridmikroskeem



IBM POWER5



TTÜ1918



# VLSI füüsiline disain

- **Loogika tase**

- loogikaelementid / loogikaavaldised
- ahdad / bitid

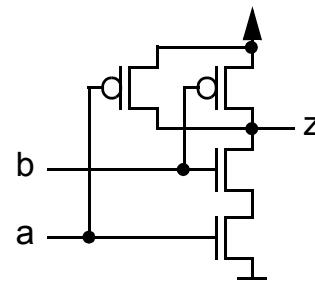
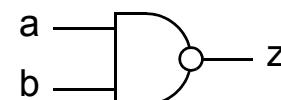
- **Füüsika tase**

- transistorid / traadid

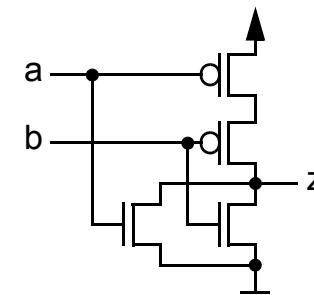
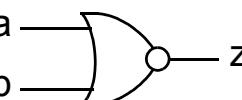
- polügonid

vt. ka <http://www.vlsitechnology.org/>

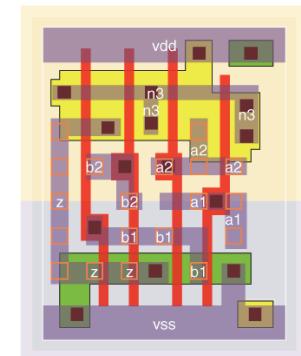
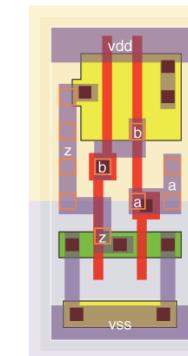
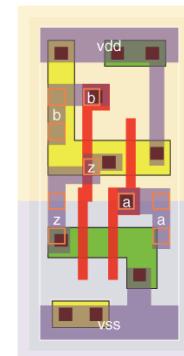
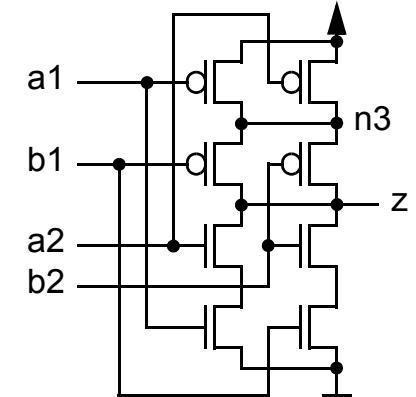
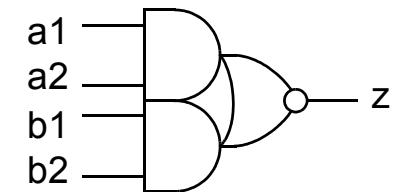
2-NAND



2-NOR



2-2-AND-NOR



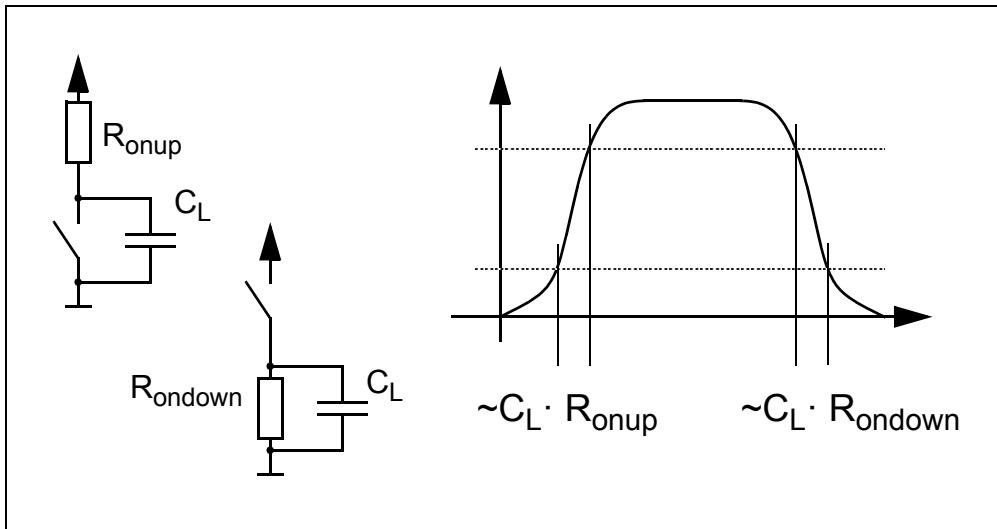
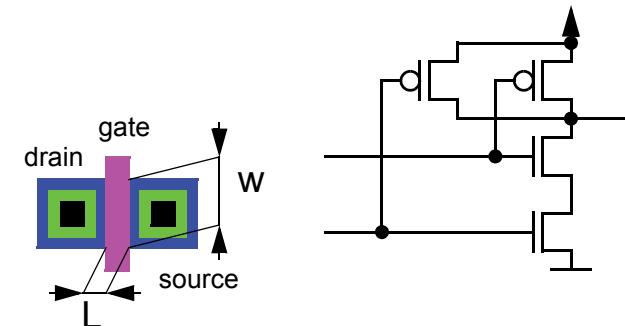


TTÜ1918



## CMOS - miks NAND?

- Materjalide omadused – mobiilsus –  
 $\mu_n = 1250 \text{ cm}^2 / \text{V sec}$  &  $\mu_p = 480 \text{ cm}^2 / \text{V sec}$
- $R \sim \mu^{-1}$  &  $R \sim L w^{-1}$  ( $L$  - konstant)



The figure shows a circuit diagram of a CMOS inverter with a resistive load. To the right are four equations describing the resistance and current relationships:  
 $R \sim \mu^{-1} w^{-1}$   
 $w_p \sim 3 \cdot w_n$  ( $R_p = R_n$ )  
 $R_p || R_p \sim R_n + R_n$   
 $R_p \sim 4 \cdot R_n$  ( $w_p = w_n$ )

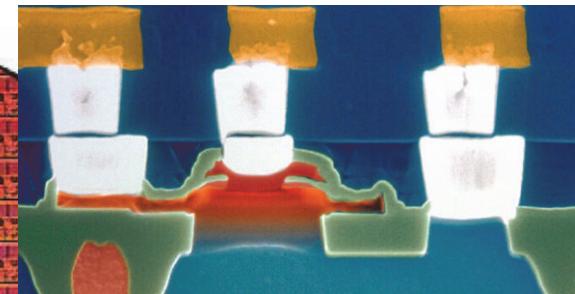
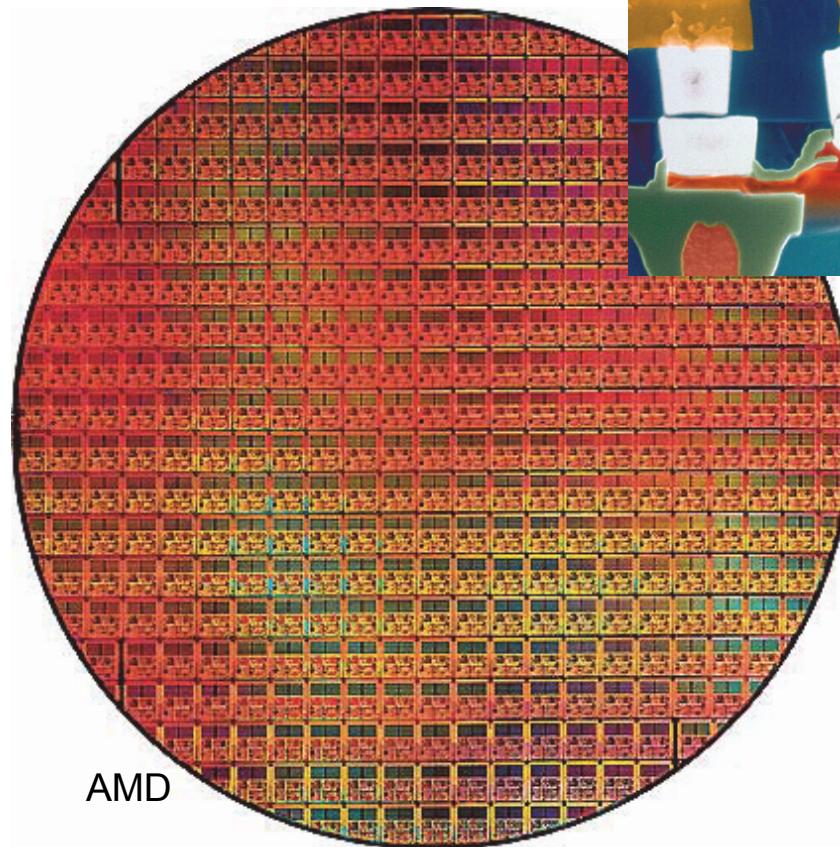


TTÜ 1918

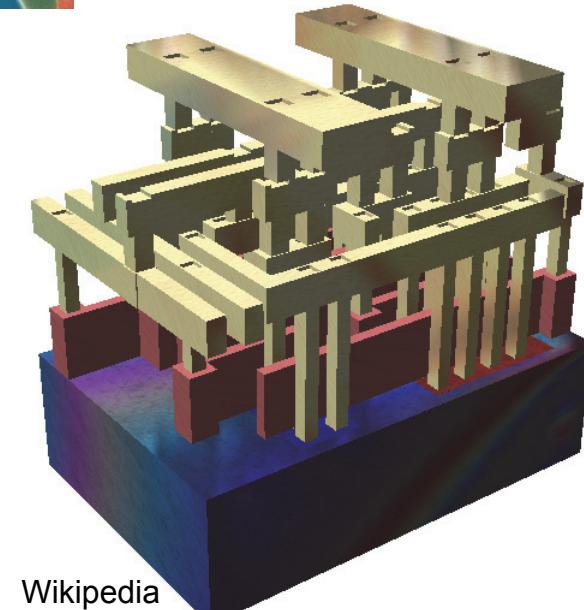
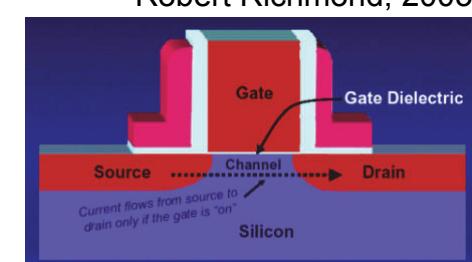


# Mikroskeemide valmistamine

- maskid – ilmutamine
- söövitamine / lisamine
- pakendamine
- testimine



Brown University

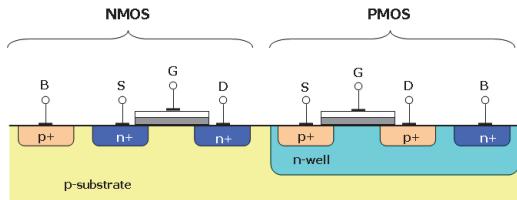




TTÜ 1918



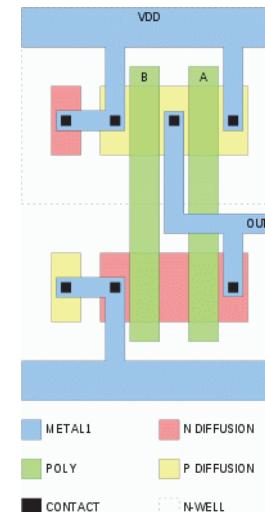
## CMOS transistorid



n - elektronid [P, As, Sb]  
p - augud [B, Al]

<http://jas.eng.buffalo.edu/>  
CMOS inverter fabrication

## 2-NAND pinnalaotus



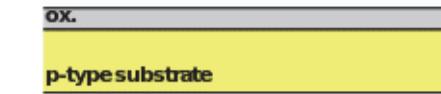
## Protsessi sammud

### söövitamise sammud

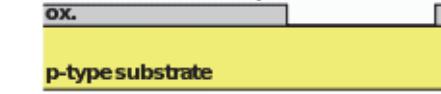
- Prepare wafer  
oxide  
substrate
- Apply photoresist  
PR  
oxide  
substrate
- Align photomask  
glass  
Cr  
PR  
oxide  
substrate
- Expose to UV light  
glass  
Cr  
PR  
oxide  
substrate
- Develop and remove photoresist exposed to UV light  
PR  
oxide  
substrate
- Etch exposed oxide  
PR  
oxide  
substrate
- Remove remaining photoresist  
oxide  
substrate

### valmistamise sammud

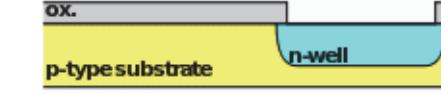
#### 1. Grow field oxide



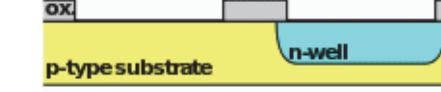
#### 2. Etch oxide for pMOSFET



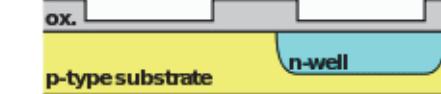
#### 3. Diffuse n-well



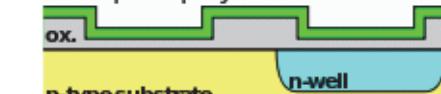
#### 4. Etch oxide for nMOSFET



#### 5. Grow gate oxide



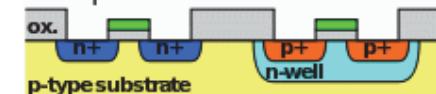
#### 6. Deposit polysilicon



#### 7. Etch polysilicon and oxide



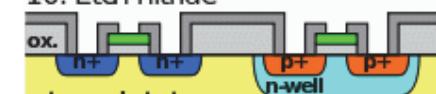
#### 8. Implant sources and drains



#### 9. Grow nitride



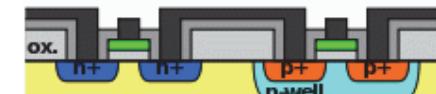
#### 10. Etch nitride



#### 11. Deposit metal



#### 12. Etch metal



[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

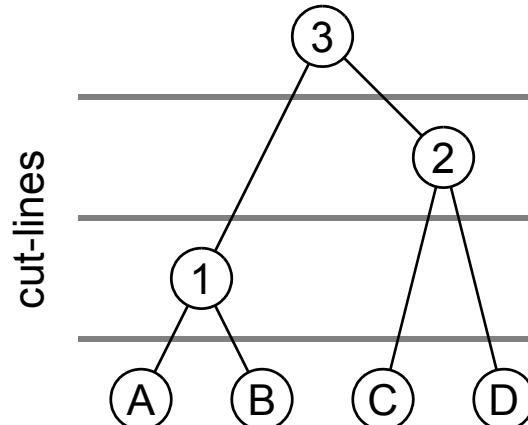
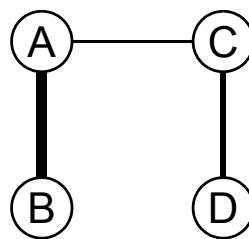


TTÜ 1918

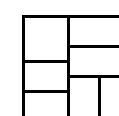
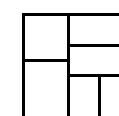
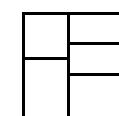
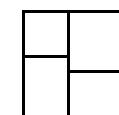
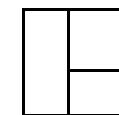
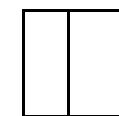


# Pinnalaotuse süntees

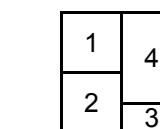
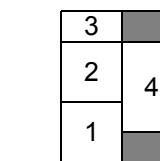
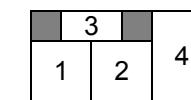
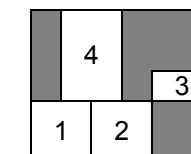
- Tükeldamine



- Pinnaplaneering



- Paigaldamine





TTÜ 1918

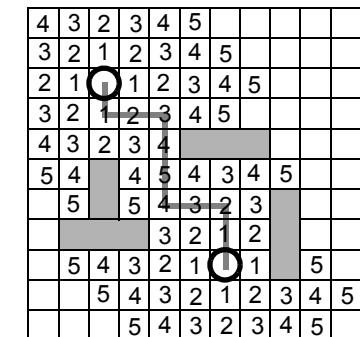
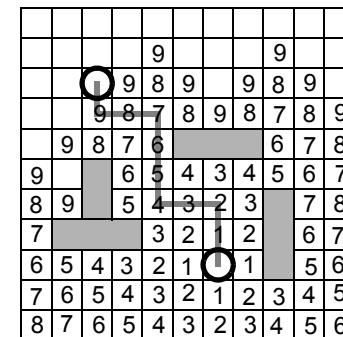


# Pinnalaotuse süntees

- **Ruutimine (trasseerimine)**

- labürindi läbimine
  - vajab palju mälu!
  - kahesuunaline otsimine
  - mitmekihiline ruutimine

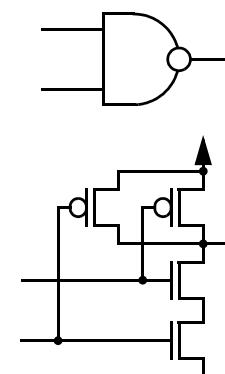
Ruutimine



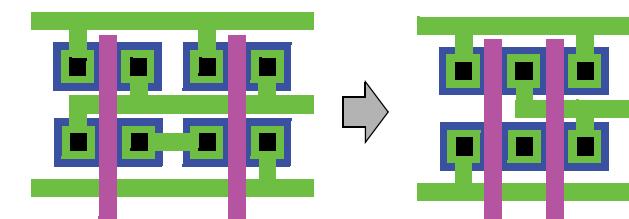
- **Pinnalaotuse optimeerimine**

- **Pinnalaotuse kontroll**

- **DRC (Design Rule Check)**



Optimeerimine



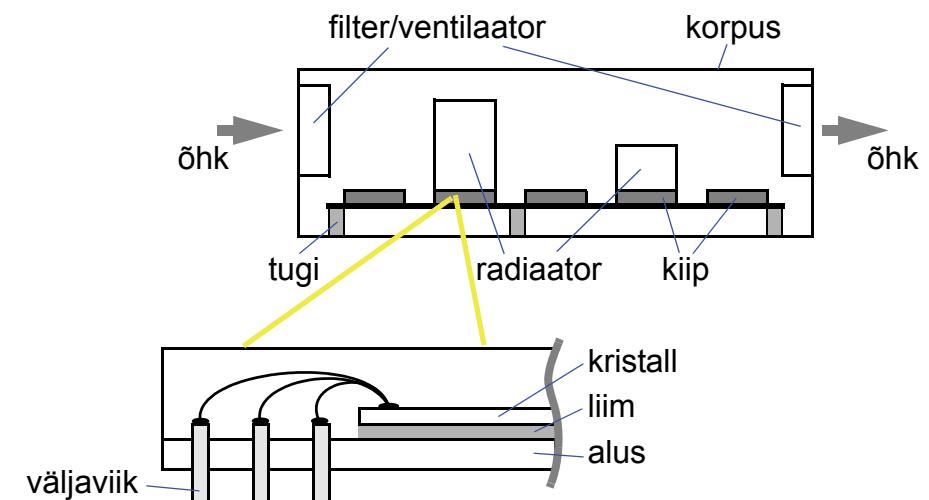
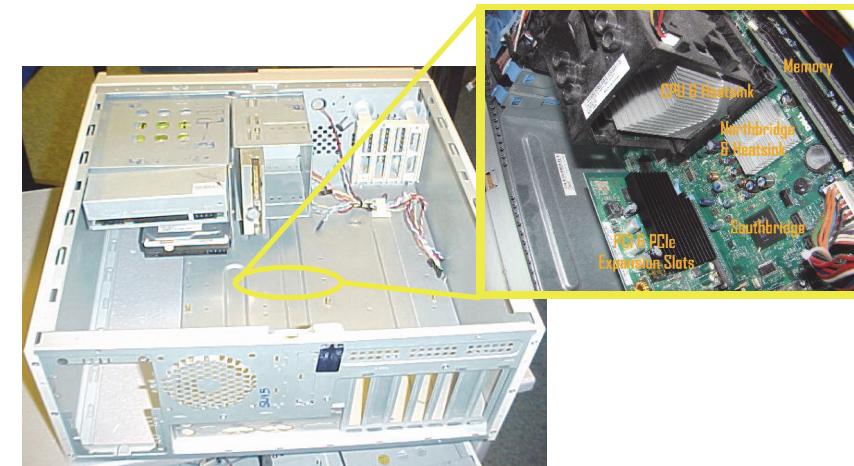


TTÜ1918



## Pakendamine - korpused

- **Füüsilised nõuded ja piirangud**
  - mõõtmed, liidesed
  - vastupidavus - tolm, vibratsioon
- **Termilised nõuded ja piirangud**
  - töötemperatuuri vahemik
  - jahutamine / küte
- **Elektrilised nõuded ja piirangud**
  - elektritoide
  - kaitse - liigpinge, elektromagnetväljad
- **Ergonomilised nõuded ja piirangud**
  - väljanägemine, kasutajaliides, müra





TTÜ 1918

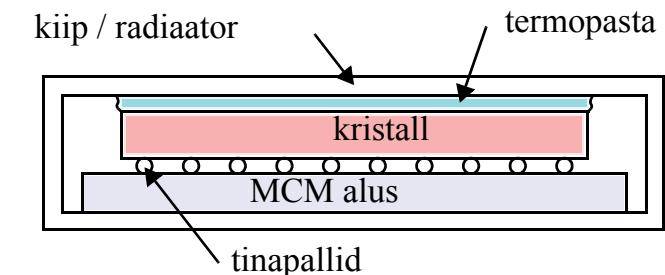
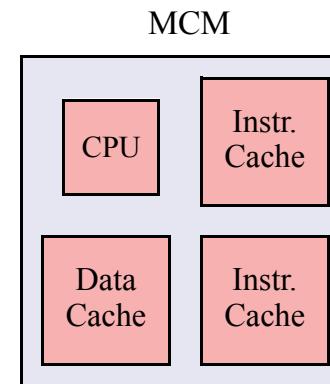


# Termilised probleemid

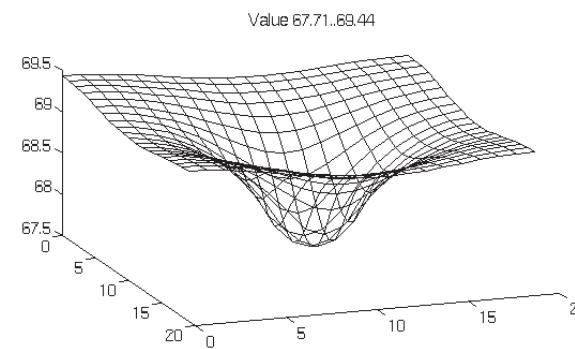
- **Jahutamine**

- **Näidisdisain (MCM)**

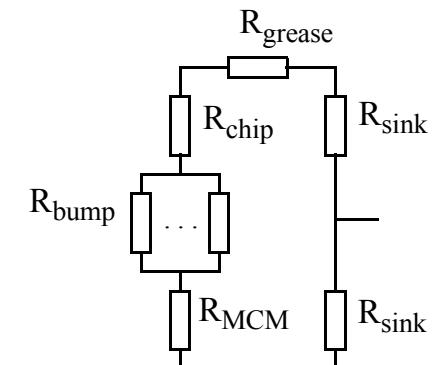
- CPU -  $68 \text{ mm}^2$ , cache -  $112 \text{ mm}^2$
- koguvõimsus - 72 W
- soojuse eemaldamine
  - kristall (GaAs):  $46 \text{ W/mK}$
  - väljaviiigud (tinapallid):  
 $d = 0.1 \text{ mm}$ , samm  $0.25 \text{ mm}$ ,  $36 \text{ W/mK}$   
(CPU 361 & cache 441)
  - termopasta:  
paksus  $0.2 \text{ mm}$ ,  $1.1 \text{ W/mK}$
  - MCM alus (alumina):  
 $27 \times 27 \text{ mm}$ ,  $20 \text{ W/mK}$
  - kiip/radiaator (Al):  $238 \text{ W/mK}$



Temperatuuri jaotus väljaviiigu ümbruses



Soojusvoo mudel





TTÜ1918

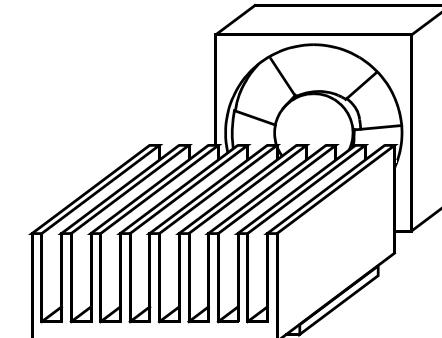
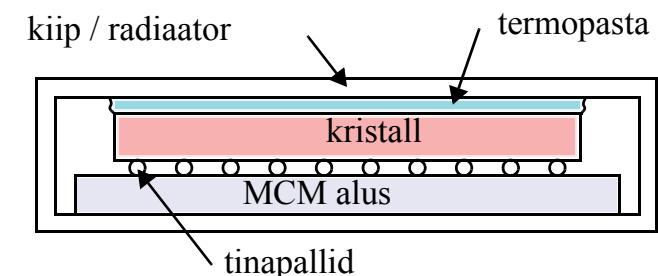


# Termilised probleemid

- **Jahutamine (järg)**

- **temperatuuride vahed**
  - väljaviiik & MCM: 20-25 K
  - koos termopastaga: 15-16 K
- **radiaator**
  - vaba õhuvool:  $5 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - sundjahutus (ventilaator):  $50 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - kristalli temperatuur  $\leq 80^\circ\text{C}$
  - radiaatori pindala [ $\text{cm}^2$ ]:

Radiaatori temperatuur [ $^\circ\text{C}$ ]	Keskkonna temperatuur			
	vaba õhuvool		sundjahutus	
	50 $^\circ\text{C}$	30 $^\circ\text{C}$	50 $^\circ\text{C}$	30 $^\circ\text{C}$
64.0	10286	4237	1029	424



- **Termiline paisumine**

- kristall (GaAs):  $6.8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  (paisub kuni  $1.4 \mu\text{m}$ ); MCM alus (alumina):  $7.7 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

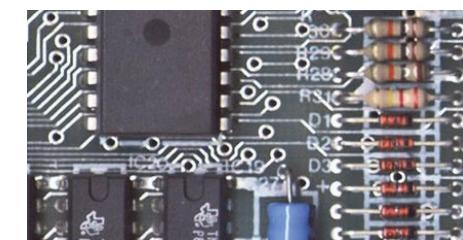


TTÜ1918



## Trükkplaadid

- **PCB (Printed Circuit Board)**
- **Valmistamine ja projekteerimine**
  - töökindlus, maksumus, jõudlus...
  - Komponendid
    - mikroskeemid, transistorid, takistid, kondensaatorid jne.
  - Ühendused
  - Liidesed
  - Kinnitused
- **Trükkplaadi valmistamine**
- **Komponentide paigaldamine (ja kinnitamine)**
- **Elektriliste ühenduste loomine (nt. jootmine)**





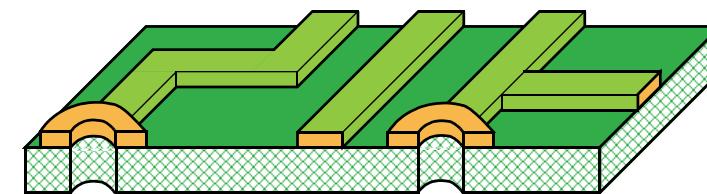
TTÜ1918



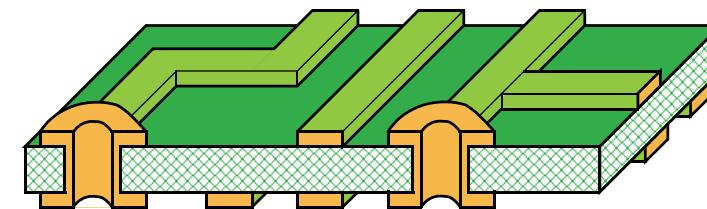
# Trükkplaatide valmistamine

- **Vasega (Cu) kaetud tekstoliit (klaasriie+epoksüvaik)**
- **Ühekihilise trükkplaati**
  - ühendusrajad (alumine pool)
- **Kahekihilise trükkplaati**
  - ühendusrajad
  - metalliseeritud läbiviigud
- **Mitmekihilise trükkplaati**
  - mitu kahekihilist plaati
  - läbiviikude asukohad!

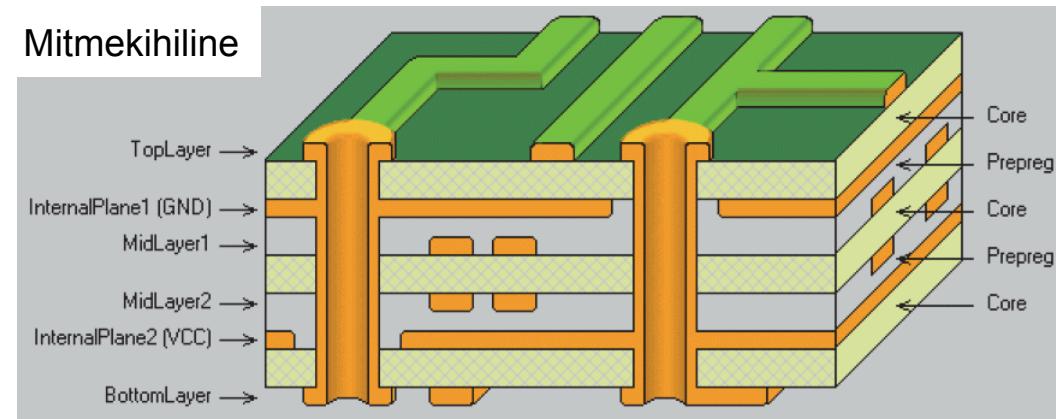
Ühekihilise



Kahekihilise



Mitmekihilise





TTÜ1918



## Trükkplaatide valmistamine

### Väikeseeriad / üksikeksemplarid

- Täielikult vasega kaetud plaat (1- või 2-kihiline)
- Läbiviikude puurimine (drilling)
- Läbiviikude galvaaniline metalliseerimine
- Ühendusradade loomine == liigse vase eemaldamine
  - liigse metalli söövitamine (etching)
    - 1) kaitsekihi peale kandmine (radade positiivkujutis)
      - a) kaitselaki / -värvjoonistamine / siiditrükk
      - b) printimine (fototundlik materjal, termokiled jne.)
    - 2) söövitamine ( $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{HNO}_3$  jne.)
- liigse metalli välja freesimine (milling)
- Komponentide paigaldamine
  - vajaduse korral ka kinnitamine (nt. liimimine)
- Jootmine
  - mehhaniiseritud (tinalaine) või käsitsi



TTÜ1918



# Trükkplaatide valmistamine

## Suurseeriad

- Läbiviikude puurimine (metalliga katmata plaat)
- Ühendusradade loomine == vasekihi galvaaniline kasvatamine
  - keemiliselt kantakse peale õhuke vasekiht
  - radade asukohtade trükkimine (fotolitograafia)
  - galvaaniline radade kasvatamine vajaliku paksuseni (tagab ka läbiviikude metalliseerimise)
  - liigse vase eemaldamine (söövitamine)
- Kaitsekihi (-laki) ja jootevedeliku/-tinaga katmine
- Komponentide (mehhaniseeritud) paigaldamine
  - vajaduse korral ka kinnitamine (nt. liimimine)
- Jootmine
  - mehhaniiseeritud

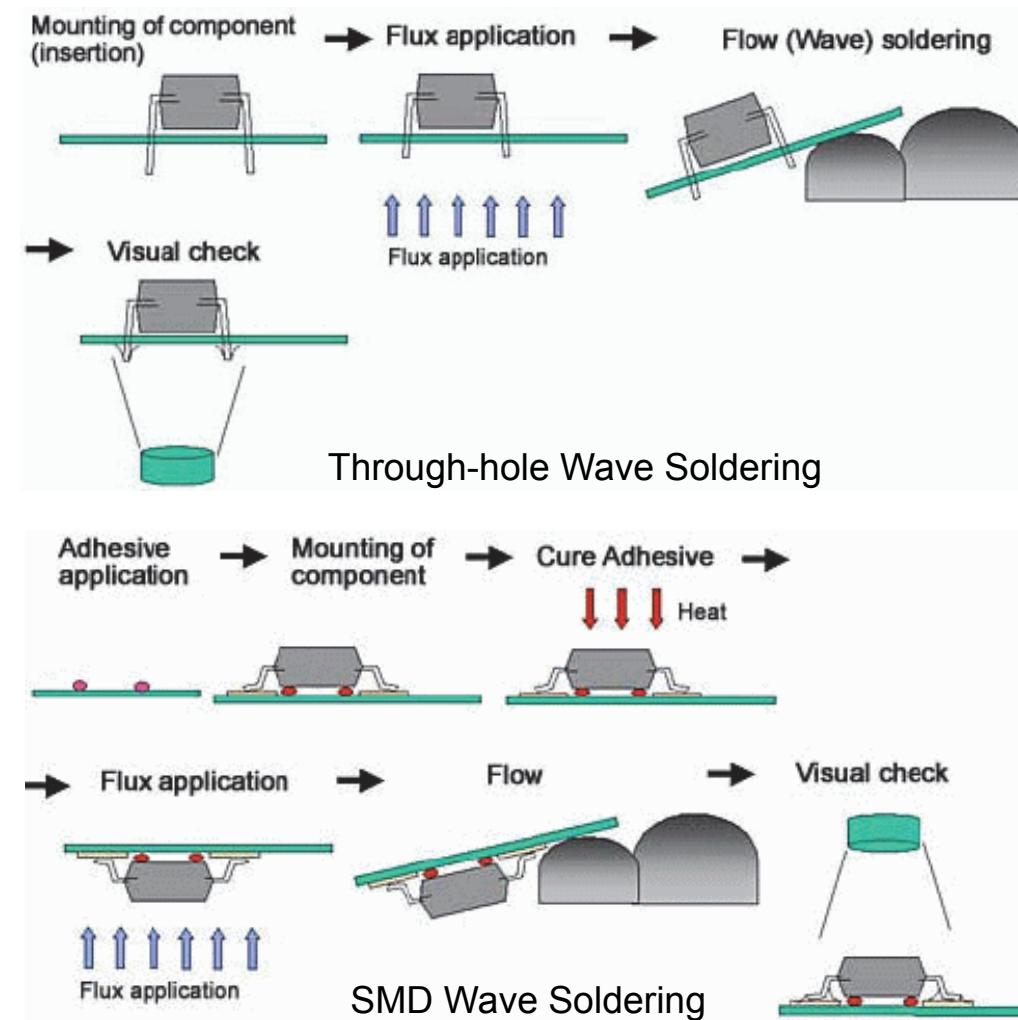


TTÜ1918



# Trükkplaatide valmistamine

- **Valmistamine**
  - komponentide kinnitamine
  - jootmine
    - jootevedelik / -tina
  - termilised probleemid
    - suured vasepinnad
    - komponentide ülekuumenemine
  - kvaliteedi kontroll
    - visuaalne
  - lõppviimistlus
    - puhastamine
    - kaitselakkimine
  - lõpptestimine
    - funktsionaalsuse kontroll





TTÜ 1918



# Trükkplaatide valmistamine

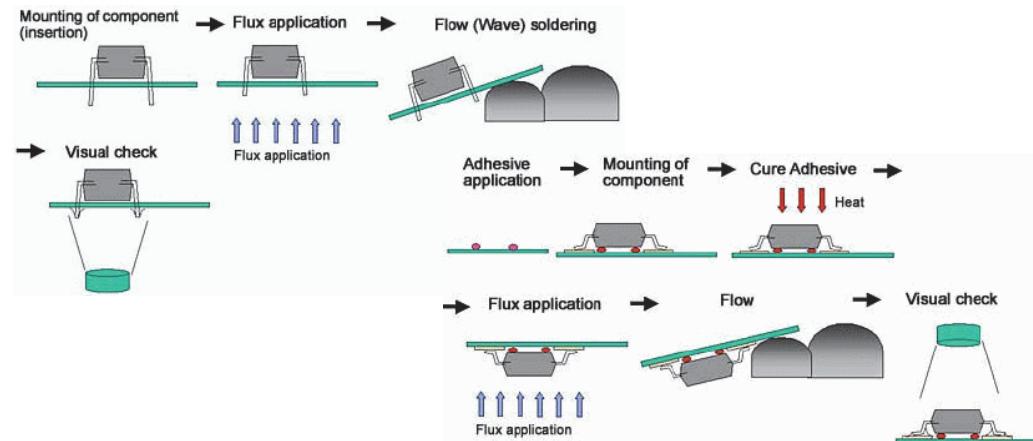
## Wave Soldering

Electro Soft Inc.

<https://www.youtube.com/watch?v=inHzaJIE7-4>

Agrowtek Inc.

<https://www.youtube.com/watch?v=VWH58QrprVc>



## SMD Reflow Soldering

GIGABYTE factory tour

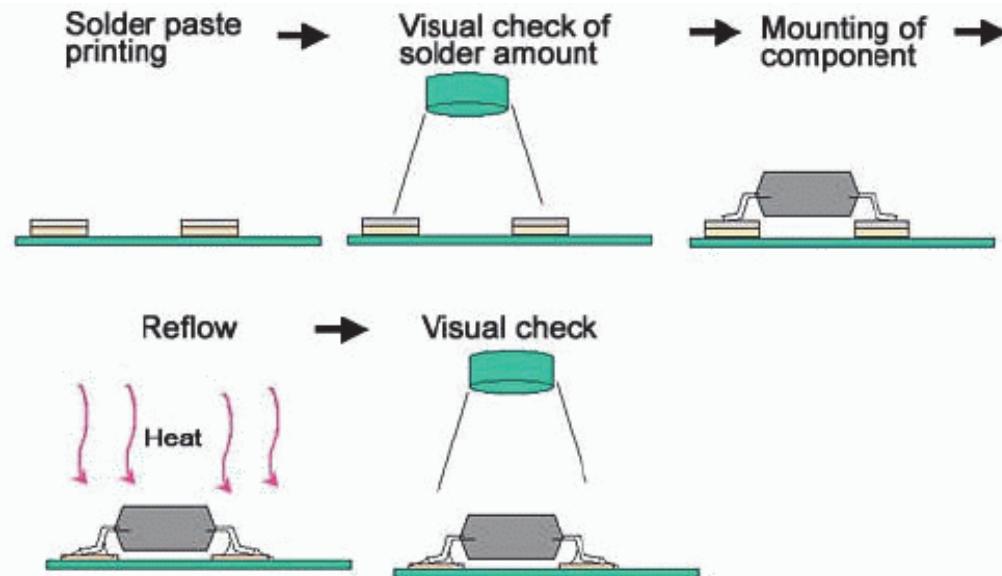
<https://www.youtube.com/watch?v=Va3Bfjn4inA>

Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=gu0v8lfLcKg>

SMD reflow at home

<https://www.youtube.com/watch?v=U48Nose31d4>





TTÜ1918



# Trükkplaatide valmistamine

## Praktilisi nõuandeid

- Möötühik on *mil* (1/1000 tolli, st. 0,0254 mm)
- Augud
  - mida väiksem auk, seda kallim plaat
  - väikseimad augud võiksid olla 0,5 mm või suurem
  - mida paksem plaat, seda suuremad augud – 2 mm plaat -> mitte alla 0,4 mm augud
- Ühendusrajad
  - liiga kitsad rajad ja radadevahed tekitavad probleeme
  - soovitav laius 0,25 mm (10 mil)
- Polügonid (suured pinnad, nt. maakiht)
  - kasutatakse ekraaniks, jahutamiseks jne.
  - väikseim vahe polügoni ja radade vahel vähemalt 0,25 mm
- Jootemask
  - kõikide jooteplatside jaoks peaks olema jootemaskis (kaitselakk) vastav auk
- Markeering
  - ei tohi sattuda jootekohtadele, täpsus ~0,5 mm

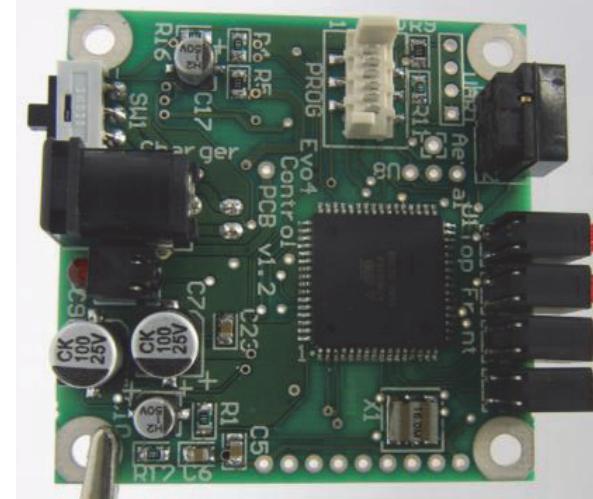
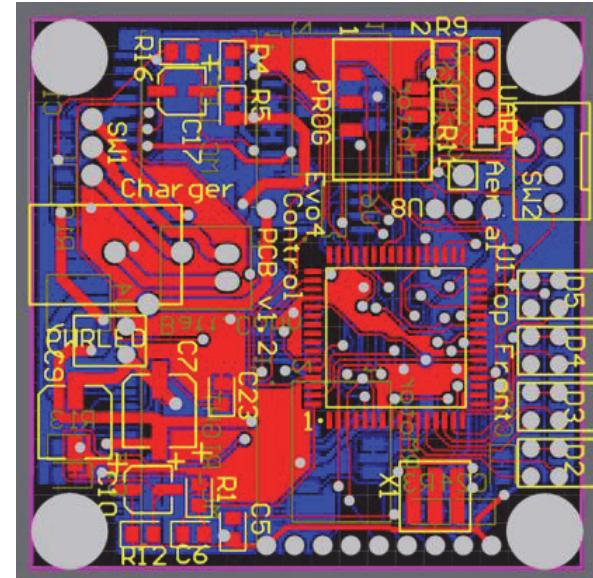


TTÜ1918



# Trükkplaatide projekteerimine

- Skeemist moodulini
  - Skeemi sisestamine
  - Komponentide paigaldamine
    - siinide asukohad
    - tugikomponendid
  - Ruutimine
    - harakapesa (rat-nest) asendamine traatidega
    - toiteühendused
  - Kontroll (DRC)
    - radade mõõtmed
    - radadevahelised kaugused
    - aukudevahelised kaugused
    - jne.



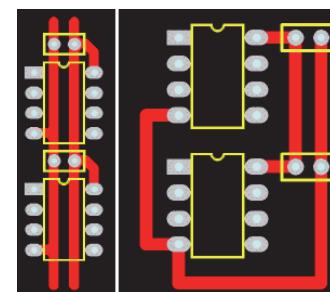
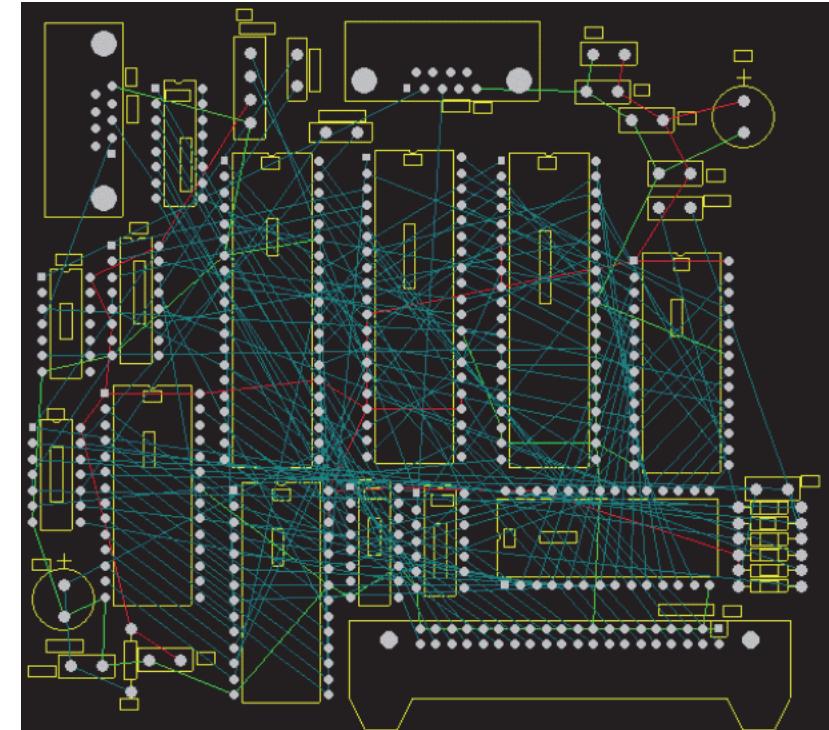


TTÜ1918

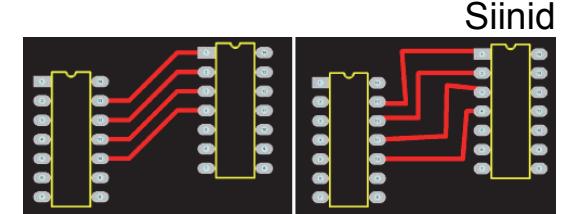


# Trükkplaatide projekteerimine

- Projekteerimine
- PCB Design Tutorial
  - David L. Jones
  - <http://www.alternatezone.com/>
- Mõningaid soovitusi
  - Toite ühendamine
    - filterkondensaatorid
  - Siinide ühendamine
  - Mitmekihilised plaadid
    - läbiviikude tüübidi – läbi terve plaadi, (osaliselt) peidetud
    - läbiviikude asukohad – sünkroniseerimine
- EAGLE
  - Easily Applicable Graphical Layout Editor
  - CadSoft Online – <http://www.cadsoft.de/>



Toide



Siinid

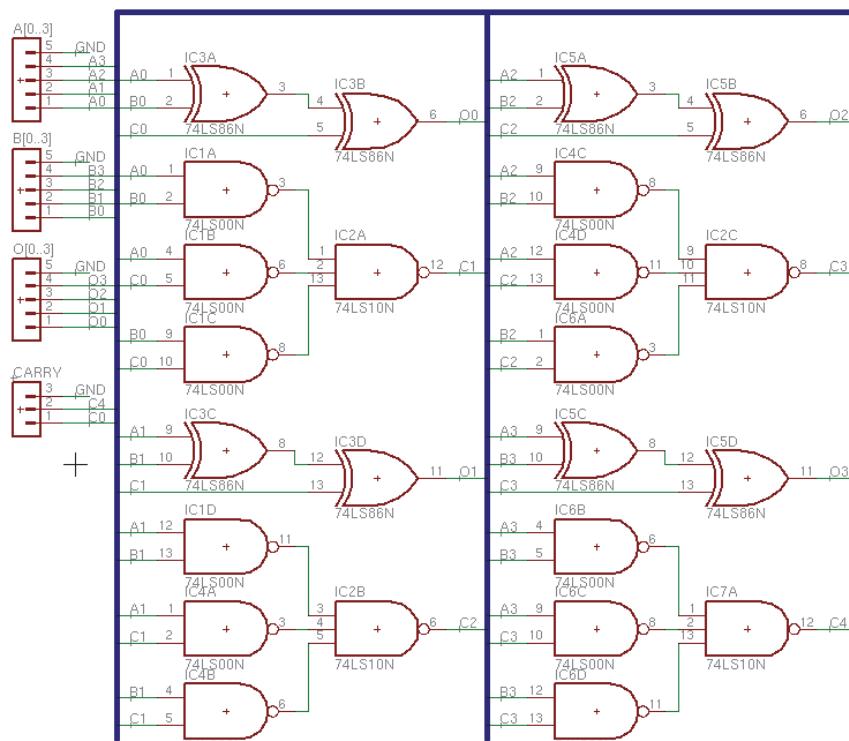
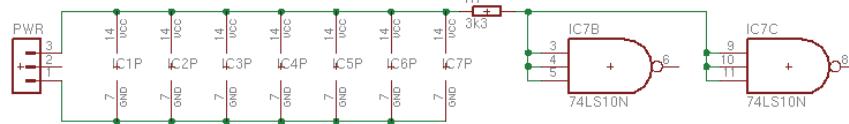


TTÜ 1918

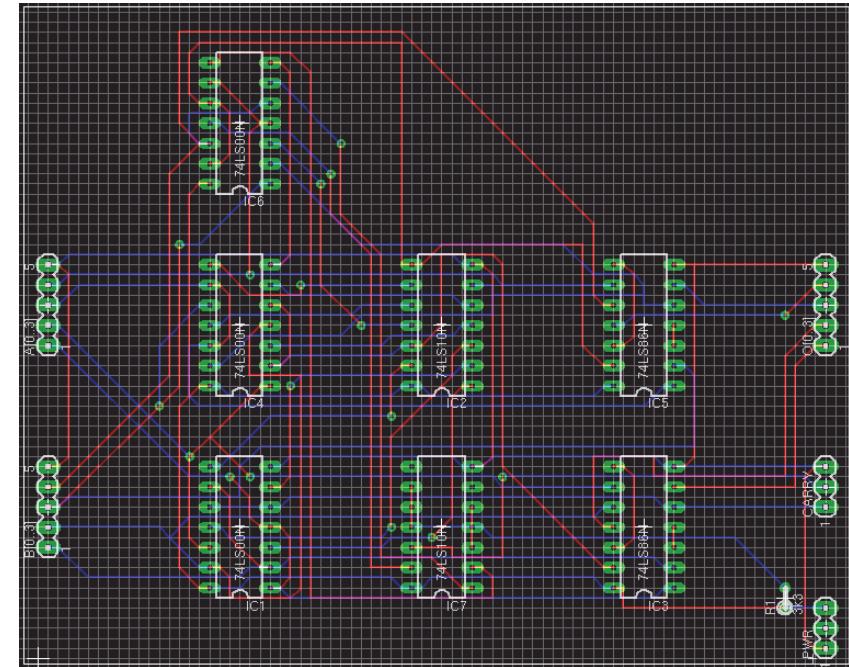


# Näidisdisain – 4-bitine summaator

7 kiipi: 2x(4x2-XOR), 3x(4x2-NAND), 2x(3x3-NAND)



36 ahelet, 82 ühendust, 17 läbiviiku



36 ahelet, 82 ühendust, 64 läbiviiku

